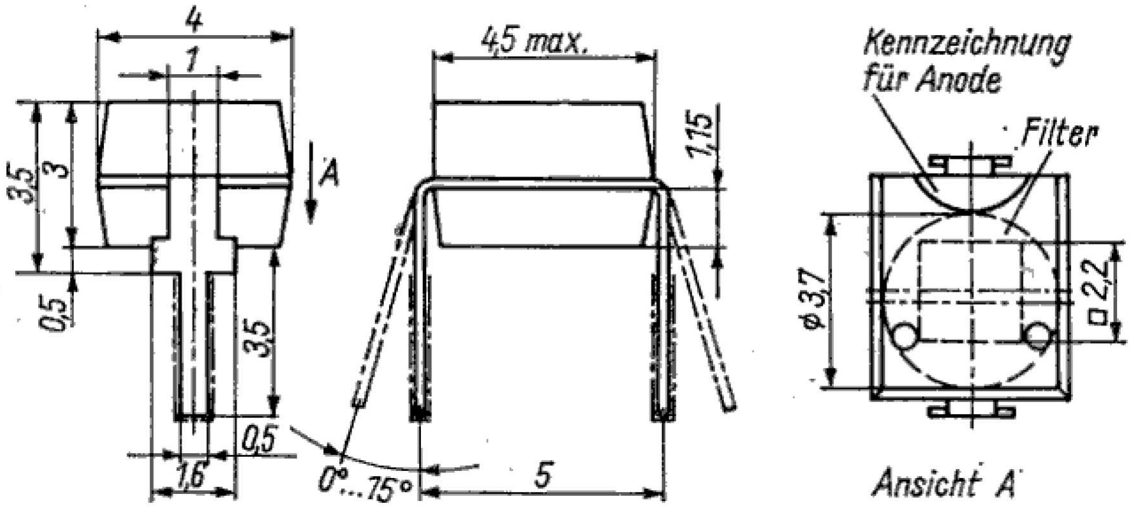
SP 106

Si-pin-Diode

- hohe Empfindlichkeit im nahen Infrarotbereich
- geringes Dunkelstromniveau
- als Empfänger für die Infrarotsignalübertragung besonders geeignet

---

Bauform 9



Grenzwerte $\vartheta_a = -25 \ldots 85\ °C$

Sperrspannung	U_R	≤ 25	V
periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	≤ 25	V
Verlustleistung $\vartheta_a = 25\ °C$	P_{tot}	≤ 150	mW
Betriebstemperatur	ϑ_a	−25 . . . +85	°C
Lagerungstemperatur	ϑ_{stg}	+5 . . . +35	°C
bis zu 30 Tagen	ϑ_{stg}	−40 . . . +85	°C

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25\ °C$

Kurzschlußstrom $E_V = 1$ klx, $R_L = < 10\ \Omega$	I_K	≧ 50	µA
Leerlaufspannung $E_V = 1$ klx, $R_L = > 10^7\ \Omega$	U_O	≧ 330	mV
Dunkelstrom $U_R = 10$ V, $E_e = 0$	I_{RO}	≤ 30	nA
Spektrale Empfindlichkeit	S_λ	≧ 0,5	A/W
Anstiegszeit	t_r	≤ 80	ns
Abfallzeit $U_R = 10$ V, $R_L = 50\ \Omega$	t_f	≤ 80	ns